Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ястребов Олег Федераяльное государственное автономное образовательное учреждение должность: Ректор высшего образования «Российский университет дружбы народов» Дата подписания: 17.06.2022 11:51:47

Уникальный программный ключ:

ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

Инженерная академия

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Технология производства гетероструктурных интегральных схем

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

Инженерно-физические технологии в наноиндустрии (совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева)

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Технология производства гетероструктурных интегральных схем» является получение знаний, умений, навыков и опыта деятельности в области технологического технологических процессов планарной технологии; основных приемов формирования структур элементов интегральных схем; принципов действия технологического оборудования и режимов выполнения технологических операций. Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при выполнении практических работ, и самостоятельной работе с учебной и технической литературой.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Технология производства гетероструктурных интегральных схем» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении

дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)	
ПК-5	Способность разрабатывать технологии изготовления наноструктурированных покрытий с заданными свойствами и проводить исследования их характеристик	ПК-5.1. Знает основные технологии изготовления наноструктурированных покрытий с заданными свойствами ПК-5.2. Умеет проводить исследования характеристик наноструктурированных покрытий с заданными свойствами ПК-5.3. Владеет методами разработки технологии изготовления наноструктурированных покрытий с заданными свойствами	
ПК-7	Способность разрабатывать современные технологические процессы изготовления наноэлектронных изделий	ПК-7.1. Знает основные современные технологические процессы изготовления наноэлектронных изделий ПК-7.2. Владеет навыками разработки современных технологических процессов изготовления наноэлектронных изделий	
ПК-8	Способность разрабатывать новые технологические процессы производства микрои наноразмерных электромеханических систем	ПК-8.1. Знает основные современные технологические процессы производства микро- и наноразмерных электромеханических систем ПК-8.2. Владеет навыками разработки новых технологических процессов производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Технология производства гетероструктурных интегральных схем» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Технология производства гетероструктурных интегральных схем».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению

запланированных результатов освоения дисциплины

200.00000000000000000000000000000000000	ованных результатов ос 	Предшествующие	Последующие		
Шифр	Наименование	дисциплины/модули,	дисциплины/модули,		
T F	компетенции	практики*	практики*		
	Способность	•	Оптические измерения		
	разрабатывать		Технология нанесения тонких		
	технологии изготовления		пленок		
	наноструктурированных		Диагностические системы в		
	покрытий с заданными		нанотехнологиях		
	свойствами и проводить	Аддитивные технологии	Технология изготовления		
	исследования их		устройств нано- и		
	характеристик		микросистемной техники		
ПК-5			Технология производства		
			гетероструктурных		
			интегральных схем		
			Технологии производства		
			оптоэлектронной базы		
			Технологии изготовления		
			лазеров на основе наноструктур		
			Технологическая практика		
			Преддипломная практика		
			Технология нанесения тонких		
			пленок		
			Технология изготовления		
	Способность		устройств нано- и		
	разрабатывать		микросистемной техники		
	современные		Технология производства		
ПК-7	технологические		гетероструктурных		
	процессы изготовления		интегральных схем Технологии производства		
	наноэлектронных		оптоэлектронной базы		
	изделий		Технологии изготовления		
			лазеров на основе наноструктур		
			Технологическая практика		
			Преддипломная практика		
			Технология нанесения тонких		
	Способность разрабатывать новые технологические процессы производства микро- и наноразмерных		пленок		
			Технология изготовления		
			устройств нано- и		
			микросистемной техники		
		Аддитивные технологии	Технология производства		
пкδ			гетероструктурных		
ПК-8			интегральных схем		
			Технологии производства		
	электромеханических систем		оптоэлектронной базы		
	Ono i owi		Технологии изготовления		
			лазеров на основе наноструктур		
			Технологическая практика		
			Преддипломная практика		

^{* -} заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Технология производства гетероструктурных интегральных схем» составляет 5 зачетных единиц.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для <u>ОЧНОЙ</u>

формы обучения

Вид учебной работы		всего,	Семестр(-ы)			
		ак.ч.	1	2	3	4
Контактная работа, ак.ч.	51		51			
	•					
Лекции (ЛК)		51		51		
Лабораторные работы (ЛР)		-		-		
Практические/семинарские занятия (С3)		17		17		
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.		93		93		
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.		36		36		
Of war the same and the same an	ак.ч.	180		180		
Общая трудоемкость дисциплины	зач.ед.	5		5		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
Раздел 1. Понятие технологии гетероструктурных интегральных схем	Тема 1.1. Основные технологические процессы. Планарная технология. Характеристика современной технологии ИМС	ЛК, СЗ
Раздел 2. Подготовка подложек	Тема 2.1. Ориентирование кристаллов. Механическая обработка;	ЛК, СЗ
Раздел 3. Легирование полупроводниковых подложек	Тема 3.1. Диффузия примесей в полупроводник. Диффузия в потоке газа-носителя. Измерение параметров диффузионных слоев. Легирование полупроводников ионным внедрением. Радиационные эффекты в кремнии. Отжиг имплантированного кремния.	ЛК, СЗ
Раздел 4. Нанесение пленок на поверхность подложек	Тема 4.1. Хлоридный и гидридный методы эпитаксии. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Термическое окисление. Вакуумное напыление. Схема вакуумной установки. Ионно-плазменное напыление тонких плёнок. Магнетронные системы напыления. Химическое осаждение тонких плёнок из газовой фазы.	ЛК, СЗ
Раздел 5. Получение рисунка элементов гетероструктурных интегральных схем	Тема 5.1. Ионно-плазменное травление. Фотолитография. Позитивные и негативные фоторезисты. Методы создания фотошаблонов. Электронолитография. Особенности литографии нанометровых размеров.	ЛК, СЗ
Раздел 6. Типовой технологический процесс	Тема 6.1. Изоляция элементов в интегральных микросхеммах. Изоляция р-п переходом. Изоляция диэлектрическими плёнками. Локальное окисление. Типовой технологический процесс изготовления изопланарной биполярной СБИС. Типовой технологический процесс изготовления п-канальных МОП СБИС. Металлизация ИС. Разводка на основе плёнок	ЛК, СЗ

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
	алюминия. Сборка интегральных микросхем. Методы	
	присоединения кристаллов. Метод термокомпрессии,	
	ультразвуковой сварки.	

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количествешт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

^{* -} аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО!

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

- 1. Кондрашин А.А., Лямин А.Н., Слепцов В.В. Современные технологии изготовления трехмерных электронных устройств: Учеб. пособие. М.: Техносфера, $2019.-210~\rm c.$
- 2. K. Reinhardt, W. Kern. Handbook of silicon wafer cleaning technology. Thrid edition $2018.-773~\mathrm{p}$

Дополнительная литература:

1. Мочалкина О.Р.;Березин А.С.

Технология и конструирование интегральных микросхем: Учеб. пособие для вузов, Березин А.С., Мочалкина О.Р., М., Радио и связь, 1992.

2. Курносов А.И.;Юдин В.В.

Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем : учеб. пособие для вузов, А. И. Курносов, В. В. Юдин, М., Высш.школа, 1986.

3. Таиров Ю.М.;Пичугин И.Г.

Технология полупроводниковых приборов : , И.Г. Пичугин; Учеб.пособие для вузов, М., Высш.школа, 1984.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
- _ЭБС «Троицкий мост»
- 2. Базы данных и поисковые системы:
- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/
- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
- поисковая система Google https://www.google.ru/
- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
- РИНЦ национальная библиографическая база данных научного цитирования https://elibrary.ru/authors.asp

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля*:

- 1. Курс лекций по дисциплине «Технология производства гетероструктурных интегральных схем».
- * все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС!

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Технология производства гетероструктурных интегральных схем» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

* - OM и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

РАЗРАБОТЧИКИ: Ассистент кафедры нанотехнологий и микросистемной техники Должность, БУП РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:	Подпись	П.А. Михалев Фамилия И.О.
Заведующий кафедрой		
нанотехнологий и микросистемной	\mathcal{O}	С.В. Попов
техники	-AM	
Наименование БУП	Поднись	Фамилия И.О.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: Ассистент кафедры нанотехнологий и микросистемной техники	An	С.В. Агасиева
Должность, БУП	Подпись	Фамилия И.О.